# 一种提高频率选择表面通带透射比的新方法

朱华新1,2 高劲松1 冯晓国1 赵晶丽1 梁凤超1 王岩松1 陈 新1

(<sup>1</sup>中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室,吉林长春130033)
<sup>2</sup>中国科学院研究生院,北京100049

摘要 为得到带宽较窄且透射比较高的频率选择表面(FSS)结构,以Y环单元为基础提出了一种提高通带透射比的新方法,即在周期单元内设置圆形孔径,运用谱域 Galerkin 方法对这种结构的传输特性进行了数值分析,确定 R=0.4 mm,单元周期内圆孔个数为12,中心频点15 GHz的透射比提高0.12 dB;采用镀膜与光刻相结合的技术 制备了相应的试验件,并进行了微波测试,测试值与计算值基本一致。结果表明,开圆孔Y环的中心频点透射比在 电磁波垂直入射的情况下为-0.69 dB,比对应Y环提高0.16 dB,而在30°和45°倾斜入射的情况下,TE 波的透射 比分别为-0.64 dB和-0.78 dB,比对应Y环分别提高了0.345 dB和0.31 dB,-3 dB带宽分别为1.26 GHz和 0.97 GHz,两种结构的带宽基本一致。因此这种方法是大周期下提高通带透射比的有效方法。

关键词 光学器件;滤波器;频率选择表面;透射比;带宽

中图分类号 TN975 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS201131.0223002

## A New Method of Improving Frequency Selective Surface Passband Transmittance

Zhu Huaxin<sup>1,2</sup> Gao Jinsong<sup>1</sup> Feng Xiaoguo<sup>1</sup> Zhao Jingli<sup>1</sup> Liang Fengchao<sup>1</sup> Wang Yansong<sup>1</sup> Chen Xin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Key Laboratory of Optical System Advanced Manufacturing Technology, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun, Jilin 130033, China <sup>2</sup> Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract Based on a Y loop element, a new method which sets circular slot on the periodic element to improve frequency selective surface (FSS) structure of narrow bandwidth and high transmittance is presented. The FSS structure is calculated by Galerkin's method in spectral domain. The optimum radius is 0.4 mm, and the numbers of the circular slot is 12. The resonance frequency is 15 GHz, and its transmittance is increased 0.12 dB. The plane sample is fabricated by depositing coatings and lithography. The agreement between the calculated and measured values is good. Compared with the Y loop without circular slot, the results show that the transmittance of this structure which is about -0.69 dB at the resonance frequency increased 0.16 dB under the normal incidence. The transmittance at TE  $30^{\circ}$  and  $45^{\circ}$  incidence are -0.64 dB and -0.78 dB, respectively. Compared with the Y loop without circular slot 0.345 dB and 0.31 dB, respectively. And the bandwidth difference between the two structures is negligible, and they are about 1.26 GHz and 0.97 GHz under TE  $30^{\circ}$  and  $45^{\circ}$  incidence, respectively. So this method is an effective way to improve the transmittance of large periodic FSS structure at resonance frequency.

Key words optical devices; filter; frequency selective surface; transmittance; bandwidth OCIS codes 230.4000; 160.3918; 240.6700

收稿日期: 2010-05-24; 收到修改稿日期: 2010-06-25

作者简介:朱华新(1983—),男,博士研究生,主要从事光学薄膜及隐身材料设计等方面的研究。

E-mail: zhuhuaxing1312@163.com

**导师简介:**高劲松(1968—),男,研究员,博士生导师,主要从事光学薄膜的设计、制备及隐身材料等方面的研究。 E-mail: gaojs@ciomp.ac.cn

### 1引 言

频率选择表面(FSS)是由周期性排列的金属贴 片单元(带阻型),或由金属屏上周期性的开孔单元 (带通型)构成的一种二维周期阵列结构<sup>[1,2]</sup>。FSS 能够较好地控制电磁波的传输和散射,能使入射电 磁波在谐振频率处发生全反射或全透射。自 20 世 纪 70 年代以来,国内外学者已经从理论建模、数值 计算、工艺实现及其工程应用对其进行了广泛而深 入地研究。

传统的孔径型 FSS 通常用于雷达波段<sup>[3,4]</sup>,实 现选择性的全透射,即只能透过自身的自导雷达 波<sup>[5,6]</sup>。对于天线罩而言,要求有尽量窄的通带宽 度,通常采用的方法是将 FSS 单元周期变大,从而 使带宽压缩,但付出的代价是通带透射比的下降,尤 其是对于电磁波大角度入射的情况下 TE 极化波的 透射比下降的更快,因此提高通带透射比成为关键 点,而 FSS 设计本身是一个多参数设计,涉及到单 元图形的尺寸、大小及周期等,并且 FSS 的仿真是 一个较繁琐的数值计算过程。虽有一些优化设计相 关的报道,但目前的优化设计还很不成熟。本文以 谱域 Galerkin 法为基本分析方法<sup>[7,8]</sup>,利用电磁场 中的二重性原理对含有一层介质衬底的带通 FSS 进行了分析研究,提出了一种提高通带透射比的新 方法,即在 FSS 屏上再设置一些圆孔,这样开孔部 分增加了透射比,从而减小了由于角度引起的透射 比下降。但圆孔的大小必须要适合,否则由于圆孔 与单元图形的相互耦合作用,使得通带位置漂移,甚 至降低通带的透射比。

#### 2 数值算法原理

对于孔径型的 FSS 而言,它是一种周期性排布的结构,利用电磁场中的二重性原理,孔径单元由入射场激励起感应磁流,则单个单元的散射场可以表示为

$$\boldsymbol{H}_{s}(x,y) = -j_{\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\varepsilon}_{0}}\boldsymbol{F}(x,y) + \frac{1}{j_{\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\varepsilon}_{0}}}\nabla[\nabla \cdot \boldsymbol{F}(x,y)],$$
(1)

式中  $H_s$  为散射波磁场强度, F 为磁场的矢势, FSS 单元孔径表面切向磁场边界条件为  $H_{inc} + H_s = Z_s M$ ,其中  $H_{inc}$ ,  $H_s$  分别为入射波和散射波的磁场 强度, M 为等效磁流, 三者均为矢量,  $Z_s$  为表面阻 抗, 一般 FSS 屏表面导电层阻抗较小, 可视为理想 导体(PEC)表面, 即  $Z_s = 0$ 。应用傅里叶变换, 并利 用 Floquet 定理则可得到谱域表达式

$$-\begin{bmatrix}H_{\rm inc-x}\\H_{\rm inc-y}\end{bmatrix} = \frac{4\pi}{j\omega\mu_0 ab} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \begin{bmatrix}k_0^2 - \alpha_{mn}^2 & -\alpha_{nm}\beta_{mn}\\-\alpha_{nm}\beta_{mn} & k_0^2 - \beta_{mn}^2\end{bmatrix} \widetilde{G}(\alpha_{nm}, \beta_{mn}) \cdot \begin{bmatrix}\widetilde{M}_x(\alpha_{nm}, \beta_{mn})\\\widetilde{M}_y(\alpha_{nm}, \beta_{mn})\end{bmatrix} \exp(j\alpha_{nm}x)\exp(j\beta_{nm}y),$$
(2)

式中 $\hat{G}(\alpha_{mm},\beta_{mm})$ 为谱域并矢格林函数,与FSS单元 两侧的匹配介质有关。

由于 FSS 阵列是二维周期结构,由傅里叶变换 的性质可知,α,β不再是连续的值,而是取一些离散 的值,他们对应相应的 Floquet 谐波,其表达式为

$$\alpha_{nm} = \frac{2m\pi}{a} + k_x,$$
  

$$\beta_{nm} = \frac{2n\pi}{h\sin\Omega} - \frac{2m\pi}{a} \cot\Omega + k_y,$$
(3)

式中 $\Omega$ 为FSS 2个周期方向的倾斜角;a,b分别为两个周期方向的单元周期值。

$$k_x = k_0 \sin \theta \cos \varphi,$$
  

$$k_x = k_0 \sin \theta \sin \varphi,$$
 (4)

式中 θ,φ 分别为平面波入射角和方位角。

用矩量法求解(2)式,对于一般的规则图形单元 可用全域基函数将要求解的感应磁流展开,其他图 形单元如 Y 环的基函数选用子域基函数中的

$$B_x(x,y) = \Lambda_x(m+0.5)\Pi_x(n), \qquad (5)$$

$$B_{y}(x,y) = \Lambda_{y}(m) \prod_{y} (n+0.5), \qquad (6)$$

式中

$$\Pi_{x}(n) = \begin{cases} 1, & |y - n\Delta y| < \frac{\Delta y}{2}, \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$
(7)

$$\Lambda_{x}(m) = \begin{cases} 1 - \frac{|x - m\Delta x|}{\Delta x}, & |x - m\Delta x| < \Delta x, \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

(8)

式中 Δ*x* 和 Δ*y* 分别为离散的每个子单元的长和宽, 用上述基函数展开的等效磁流代入(2)式中即可以求 出等效磁流 *M*,进而可以求出反射系数和透射系数。

对于在 Y 环上设置圆孔实际上可看作基于 Y 环的一种复合结构,计算过程也与 Y 环类似,也是 采用 Rooftop 子域基函数展开表面等效磁流。

#### 3 理论设计

整个结构有 4 部分组成,如图 1 所示。1 为平 板基底,厚度为 5.6 mm,其介电常数  $\epsilon_r$ =3.2,正切 损耗 tan  $\delta$ =0.007;2 为胶合层,厚度为 90  $\mu$ m,介电 常数  $\epsilon_r$ =2.6,正切损耗 tan  $\delta$ =0.009,3 为覆铜薄膜 基底,厚度为 25  $\mu$ m,介电常数  $\epsilon_r$ =3,正切损耗 tan  $\delta$ =0.005,4 为 FSS。



图 1 FSS 的分析模型 Fig. 1 Model of FSS

FSS结构中,需要对参数不断进行优化,才能确 定单元的形状及尺寸,Y环单元形状简单,工艺精度 容易达到,适合三角形格子排布,而且电磁波大角度 入射时,Y环单元FSS中心频点的稳定性较好。因 此先从Y环单元入手,然后在此基础上设置开孔, 使其在角度变化情况下透射比降低更小,Y环单元 的结构参数如图2所示。



图 2 Y环单元尺寸示意图 Fig. 2 Dimensions of Y loop element

经反复调整该 Y 环的结构参数,取 W = 1.1 mm,W'=0.3 mm,d=0.4 mm,L=3 mm,为 了得到相对较窄的半宽度,单元周期在 x,y 方向上的值 a=8 mm,b=6.9 mm,由于是正三角形排布,倾斜角  $\Omega=60^\circ$ ,所以在两个方向上的周期值不一致。运用谱域 Galerkin 法进行计算,得到该结构的 FSS 在电磁波正入射情况下仿真频率响应特性如图 3所示。



图 3 正入射下 Y 环单元 FSS 的频率响应曲线 Fig. 3 Curve of frequency response of Y loop element FSS under the normal incidence

由图 3 看出,此 Y 环单元的中心频点为 15 GHz,透射比为一0.63 dB。由于单元周期较大, 随着电磁波入射角度的增加,TE 波的通带透射比 下降的很快。而对于某些天线罩而言,正是要求在 大角度情况下还要保证较高的透射比,因此采取在 此基础设置开孔的方法。由于为了达到带宽较窄, 单元周期较大,表面的金属导电层所覆盖面积较大, 设置开孔实际是通过圆孔增大表面的空占比(即开 孔部分面积/金属覆盖面积),使得表面开孔部分增 加电磁波通过的几率增大,从而提高了通带的透射 比,类似于金属网栅<sup>[9~11]</sup>,它是一种高通滤波器,可 以通过增大空占比,来提高光学波段的透射比。但 是设置开孔的大小和数量要适当,不然会引起开孔 与原 Y 环的耦合作用加剧,从而引起中心频点的漂 移。如图 4 是在一个图形单元中设置不同半径的圆 孔及不同的开孔数量下的中心频点 15 GHz 透 射率。



图 4 设置不同圆孔后对应中心频点透射比 Fig. 4 Transmittance at resonance frequency versus different radius and numbers of circular slot

从图 4 中可以看出,当设置半径 R=0.2 mm 圆 孔时,增加的量很不明显,而当 R=0.3 mm 时,透 射比有增加的趋势,但圆孔的个数可能较多;当 R=0.4 mm 时可以明显看出圆孔数量在 12 时出现一 个最大值,当再增加圆孔个数时,圆孔与 Y 环的耦合作用明显加剧,使得透射比逐渐下降;当  $R \ge$  0.5 mm,圆孔与 Y 环的耦合作用更加明显,随圆孔的数量增加在中心频点处的透射比急剧下降,其中主要是由于中心谐振频点的偏移引起。最终选择了R=0.4 mm的圆孔,一个单元内圆孔的个数为 12,通带的透射比为-0.51 dB,相比图 2 的初始结构透射比提高了 0.12 dB,选择其是因为其圆孔的数量比较合理,若选择半径 R < 0.4 mm的圆孔,按照图 4 所示的趋势,圆孔的数量将会较多,这样就加大了工艺的复杂性。

#### 4 实验制作及测试

通过镀膜<sup>[12~15]</sup>与光刻技术在制备出 300 mm× 250 mm 的 2 个实验件,然后再胶合到平板基底上, 其中一个为单一的 Y 环结构,另一个为 Y 环设置圆 孔的结构,后者实验件如图 5 所示。将制备好的实 验件在微波暗室进行测试,测试系统主要包括矢量 网络分析仪和 2 个测试天线及转台。测试分 2 步: 1)测试并记录无实验件时接收信号的幅度和相位, 建立参考基准;2)插入实验件,测试接收信号的幅度 和相位,将它们分别与参考基准相减得到实验件插 入损耗和插入相位移。



图 5 实际制作的实验件 Fig. 5 Photograph of FSS sample

正入射情况下图 2 的 Y 环与图 5 实验件的测 试透射比曲线如图 6 所示。无圆孔的 Y 环的中心 频点测试透射比为-0.85 dB,而带圆孔的中心频点 透射比为-0.69 dB,相比提高了 0.16 dB,-3 dB 带宽约为 1.59 GHz。

图 7 和图 8 分别为 30°和 45°入射情况下 TE 波 两者的实测透射比曲线。30°入射情况下,带有圆孔 Y环的透射比为一0.64 dB,其对应的无圆孔 Y 环的 透射比为一0.985 dB,前者比后者提高了0.345 dB, 一3 dB带宽约为 1.26 GHz;在 45°入射情况下,带有 圆孔 Y 环的透射比为一0.78 dB,其对应的无圆孔 Y 环的透射比为一1.09 dB,前者比后者提高了 0.31 dB, -3 dB带宽约为 0.97 GHz。通过大角度 测试的情况可以看出, 在单元周期较大时, TE 波的 通带带宽逐渐变小, 而通带透射比也逐渐变小, 这与 理论仿真也是一致的, 通过在单元周期内设置圆孔, 使得透射比下降的速度明显减小, 而且透射比的提 高较垂直入射也更明显。



图 6 正入射情况下两种结构透射比对照

Fig. 6 Measured frequency response character under perpendicularity incidence with two structures



图 7 30°TE 波入射情况下两种结构透射比对照 Fig. 7 Measured frequency response character under TE 30° incidence with two structures



图 8 45°TE 波入射情况下两种结构透射比对照 Fig. 8 Measured frequency response character under TE 45° incidence with two structures

### 5 结 论

通过将 FSS 单元周期变大,可以起到压缩带宽的作用,本文提出了一种减少透射比降低的方法,即

在单元内再设置圆孔,运用谱域 Galerkin 法得到当 圆孔的半径 R=0.4 mm,个数为 12 时,能够得到较 理想的透射比,采用镀膜与光刻技术制作出了相应 的等效平板实验件,并在微波暗室中对实验件进行 了测试。

测试结果表明,与对应的 Y 环相比,在电磁波 垂直入射的情况下,透射比提高了 0.16 dB;在 30° 和 45°TE 波入射的情况下,透射比的提高分别为 0.345 dB和 0.31 dB,相比垂直入射时提高更明显, 并且设置圆孔并不影响原结构的带宽,与原结构一 致随着电磁波入射角度的增加 TE 波带宽进一步的 变窄,与仿真一致。因此该方法是一种行之有效的 新方法,可以应用于在飞行兵器隐身窗口上,既能保 证相对较窄的带宽,又能保证较高透射比。

#### 参考文献

- 1 T. K. Wu. Frequency Selective Surface and Grid Array[M]. New York: Wiley-Intersci., 1995
- 2 B. A. Munk. Frequency Selective Surface: Theory and Design [M]. New York: Wiley-Intersc., 2000
- 3 Lu Jun, Zhang Jing, Sun Lianchun. Experimental comparison of the characteristics of Y element and Y loop element[J]. Optics and Precision Engineering, 2005, 13(2): 219~224
- 卢 俊,张 靓,孙连春.Y形和Y环形单元特性的试验对比研究[J]. 光学精密エ程,2005,13(2):219~224
- 4 R. Mittra, C. H. Chan, T. Cwik. Techniques for analyzing frequency selective surfaces-a review [J]. Proc. IEEE, 1988, 76(12): 1593~1615
- 5 Hou Xinyu, Wan Wei, Tong Mingan *et al.*. Analysis on the loss and bandwidth properties of FSS with multilayer dielectric substrates[J]. J. Microwave, 1999, **15**(4): 366~370 侯新宇, 万 伟, 佟明安等. 带有多层介质衬底 FSS 的损耗和 带宽特性分析[J]. 微波学报, 1999, **15**(4): 366~370
- 6 Li Xiaoqiu, Gao Jinsong, Zhao Jingli et al.. A novel element of

frequency selective surface for radome[J]. Acta Physica Sinica , 2008, 57(6): 3803 $\sim3806$ 

李晓秋,高劲松,赵晶丽等.一种适用于雷达罩的频率选择表面 新单元研究[J].物理学报,2008,**57**(6):3803~3806

- 7 Hongyan Jia, Jinsong Gao, Xiaoguo Feng *et al.*. Frequency selective surface with a flat topped passband [J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2007, 5(12): 715~716
- 8 Hongyan Jia, Jinsong Gao, Xiaoguo Feng. Closely packed dense frequency selective surface[J]. Chin. Opt. Lett., 2008, 6(6): 441~442
- 9 R. Urich. Far-infrared properties of metallic mesh and its complementary structure [J]. Infrared Physics, 1967, 7(1):  $37 \sim 57$
- 10 L. B. Whitbourn, R. C. Compton. Equivalent-circuit formulas for metal grid reflectors at a dielectric boundary[J]. Appl. Opt., 1985, 24(2): 217~220
- 11 Feng Xiaoguo, Fang Liang, Sun Lianchun. Characteristic dimension design and fabrication of metallic mesh [J]. Optics and Precision Engineering, 2005, 13(1): 59~64
  冯晓国,方 梁,孙连春. 金属网栅结构参数设计与制作[J]. 光 学精密工程, 2005, 13(1): 59~64
- 12 Zhu Huaxin, Gao Jinsong, Wang Xiaoyi *et al.*. Design of homogeneous thin film combining with Fourier-Transform synthesis method [J]. Acta Optica Sinica, 2008, 28 (12): 2436~2440 朱华新,高劲松,王笑夷等. 结合傅里叶变换合成法设计均匀薄

膜[J]. 光学学报, 2008, **28**(12): 2436~2440 13 Chunrong Xue, Kui Yi, Chaoyang Wei *et al*.. Optical constants

- of DUV/UV fluoride thin film [J]. Chin. Opt. Lett., 2009, 7(5): 449~451
- 14 Zhao Feifei, Zhao Baosheng, Zhang Xinghua et al.. Properties of germanium thin film and its application in photon counting imaging system [J]. Acta Optica Sinica, 2009, 29 (11): 3236~3240 赵菲菲,赵宝升,张兴华等. Ge 薄膜特性及其在光子计数成像

系统中的应用[J]. 光学学报, 2009, **29**(11): 3236~3240

15 Zhou Ming, Zhao Yuanan, Li Dawei *et al.*. Laser ddamage of optical film with the combined irradiation of 1064 nm and 532 nm pulse[J]. *Chinese J. Lasers*, 2009, **36**(11): 3050~3054 周 明,赵元安,李大伟等. 1064 nm 和 532 nm 激光共同辐照 薄膜的损伤[J]. 中国激光, 2009, **36**(11): 3050~3054